



Initial Product/Process Change Notification

Document # : IPCN22774XA

Issue Date: 1 August 2019

Title of Change:	Planned Capacity Expansion for SOIC 8/14 Copper Wire Products into ASE Kunshan China (ASEKS)		
Proposed First Ship date:	9 March 2020		
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < albert.reyes@onsemi.com >		
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or < PCN.Samples@onsemi.com > Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.		
Type of Notification:	This is an Initial Product/Process Change Notification (IPCN) sent to customers. An IPCN is an advance notification about an upcoming change and contains general information regarding the change details and devices affected. It also contains the preliminary reliability qualification plan. The completed qualification and characterization data will be included in the Final Product/Process Change Notification (FPCN). This IPCN notification will be followed by a Final Product/Process Change Notification (FPCN) at least 90 days prior to implementation of the change. In case of questions, contact < PCN.Support@onsemi.com >		
Change Part Identification:	Change in marking for ON Semiconductor, Carmona Philippines and ASEKS Kunshan, China. Product labeling will indicate the country where material is assembled.		
Change Category:	☐ Wafer Fab Change ☒ Assembly Change ☒ Test Change ☐ Other _____		
Change Sub-Category(s):	☒ Manufacturing Site Addition ☒ Material Change ☐ Datasheet/Product Doc change ☐ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☐ Shipping/Packaging/Marking ☐ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____		
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON Carmona, Philippines	External Foundry/Subcon Sites: ASE Kunshan	
Description and Purpose: ON Semiconductor is notifying customers of the intended capacity expansion described below. Upon completion of the process change notification series, affected devices may be manufactured at ASEKS, or any of the previously qualified assembly and test facilities, depending on ON Semiconductor capacity flexibility requirements. All products will continue to meet the existing datasheet specifications.			
	Before Change Description	After Change Description	
Leadframe	AG CU	AG CU	LF AGSPOTTED
Die Attach	SUMITOMO CRM-1076WB	SUMITOMO CRM-1076WB	HITACHI EN4900GC
Bond Wire	CUWIRE 99.99%/1.0 MIL	CUWIRE 99.99%/1.0 MIL	NIPPON 1 mil PD Cu
Mold Compound	MC EME G600	MC EME G600	CEL9240HF10AK
Assembly Site	OSPI Carmona	OSPI Carmona	ASEKS China
Test Site	OSPI Carmona	OSPI Carmona	ASEKS China
	From	To	
Product marking change	XX AYW Where : XX: device marking A : P for Carmona Site YW : two digit date code	XX AYW Where : XX: device marking A : AK for ASEKS site YW : two digit date code	

**Qualification Plan:**

Device Name : MC33274ADR2G

Package : SOIC 14

RMS :

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65 °C to +150°C	500 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1@ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec	
PD	JESD22 B100,B108		
WBS	AEC-Q100-001		
WBP	Mil-Std-883 Method 2011		

Device Name : MC33204DR2G

Package : SOIC 14

RMS :

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs

Device Name : MC33179DR2G

Package : SOIC 14

RMS :

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs

Device Name : MC33275D-3.3R2G

Package : SOIC 8

RMS :

Test	Specification	Condition	Interval
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs



Device Name : MC33272ADR2G

Package : SOIC 8

RMS :

Test	Specification	Condition	Interval
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65 °C to +150°C	500 cyc
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1@ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec	
PD	JESD22 B100,B108		
WBS	AEC-Q100-001		
WBP	Mil-Std-883 Method 2011		

Estimated date for qualification completion: 2 December 2019

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
LM201ADR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
LM201AVDR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
LM211DR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
LM2931AD-5.0R2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
LM2931CDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
LM2931D-5.0R2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
LM301ADR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
LM311DR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC1455BDR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC1455DR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC1496BDR2G	MC33274ADR2G
MC1496DR2G	MC33274ADR2G
MC33071ADR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC33071DR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC33171DR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC33201DG	MC33204DR2G, MC33204DR2G
MC33201DR2G	MC33204DR2G, MC33204DR2G



MC33201VDR2G	MC33204DR2G, MC33204DR2G
MC34071ADR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC34071DR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC78L05ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L05ACDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L08ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L09ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L12ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L12ACDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L15ABDG	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L15ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L15ACDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC79L05ABDG	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC79L05ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC79L05ACDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC79L12ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC79L12ACDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC79L15ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC79L15ACDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
NE592D14G	MC33274ADR2G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号 : IPCN22774XA

発行日 : 1 August 2019

変更件名:	SOIC 8/14 銅ワイヤー製品の ASE Kunshan China (ASEKS) への生産能力拡大計画																														
初回出荷予定日:	9 March 2020																														
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <albert.reyes@onsemi.com> にお問い合わせください。																														
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。																														
通知種別:	これは、お客様宛の初回製品 / プロセス変更通知 (IPCN) です。IPCN は、近日中に実施される変更に関する事前通知であり、変更の詳細および影響を受けるデバイスについての一般情報が記載されます。また、暫定的な信頼性認証計画も記載されます。 最終的な認定データおよび特性データは最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に含まれます。この IPCN は、変更実施から少なくとも 90 日前に発行される最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) に先だって通知されます。ご不明な点がありましたら、<PCN.Support@onsemi.com> にお問い合わせください。																														
変更部品の識別:	オン・セミコンダクター カルモナ (フィリピン) および ASEKS Kunshan (昆山、中国) についてのマーキングの変更。 製品ラベリングは材料がどこの国で組み立てられるかを示します。																														
変更カテゴリ:	☐ ウェハファブの変更 ☒ アセンブリの変更 ☒ 試験の変更 ☐ その他 _____																														
変更サブカテゴリ:	☒ 製造拠点の追加 ☒ 材料の変更 ☐ データシート/製品資料の変更 ☐ 製造拠点の移転 ☐ 製品仕様の変更 ☐ 出荷/パッケージング/表記 ☐ 製造プロセスの変更 ☐ その他: _____																														
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: ON Carmona, Philippines	外部製造工場 / 下請業者拠点: ASE Kunshan																													
説明および目的: オン・セミコンダクターは以下内容の生産能力拡大の意向を通知いたします。一連のプロセス変更通知の終了時に、対象製品は、オン・セミコンダクターの生産能力柔軟性要件に基づき、ASEKS、または以前に認定された組立および検査工場で製造される場合があります。すべての製品は既存のデータシート規格に継続して適合します。																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th colspan="2">変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リードフレーム</td> <td>AG CU</td> <td>AG CU</td> <td>LF AGSPOTTED</td> </tr> <tr> <td>ダイ接着剤</td> <td>SUMITOMO CRM-1076WB</td> <td>SUMITOMO CRM-1076WB</td> <td>HITACHI EN4900GC</td> </tr> <tr> <td>ボンドワイヤー</td> <td>CUWIRE 99.99%/1.0 MIL</td> <td>CUWIRE 99.99%/1.0 MIL</td> <td>NIPPON 1 mil PD Cu</td> </tr> <tr> <td>モールド・コンパウンド</td> <td>MC EME G600</td> <td>MC EME G600</td> <td>CEL9240HF10AK</td> </tr> <tr> <td>組立拠点</td> <td>OSPI Carmona</td> <td>OSPI Carmona</td> <td>ASEKS China</td> </tr> <tr> <td>検査拠点</td> <td>OSPI Carmona</td> <td>OSPI Carmona</td> <td>ASEKS China</td> </tr> </tbody> </table>				変更前の表記	変更後の表記		リードフレーム	AG CU	AG CU	LF AGSPOTTED	ダイ接着剤	SUMITOMO CRM-1076WB	SUMITOMO CRM-1076WB	HITACHI EN4900GC	ボンドワイヤー	CUWIRE 99.99%/1.0 MIL	CUWIRE 99.99%/1.0 MIL	NIPPON 1 mil PD Cu	モールド・コンパウンド	MC EME G600	MC EME G600	CEL9240HF10AK	組立拠点	OSPI Carmona	OSPI Carmona	ASEKS China	検査拠点	OSPI Carmona	OSPI Carmona	ASEKS China
	変更前の表記	変更後の表記																													
リードフレーム	AG CU	AG CU	LF AGSPOTTED																												
ダイ接着剤	SUMITOMO CRM-1076WB	SUMITOMO CRM-1076WB	HITACHI EN4900GC																												
ボンドワイヤー	CUWIRE 99.99%/1.0 MIL	CUWIRE 99.99%/1.0 MIL	NIPPON 1 mil PD Cu																												
モールド・コンパウンド	MC EME G600	MC EME G600	CEL9240HF10AK																												
組立拠点	OSPI Carmona	OSPI Carmona	ASEKS China																												
検査拠点	OSPI Carmona	OSPI Carmona	ASEKS China																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>製品マーキング変更</td> <td> XX AYW ここでは、 XX: デバイス表記 A: カルモナ拠点の P YW: 2 桁日付コード </td> <td> XX AYW ここでは、 XX: デバイス表記 A: ASEKS 拠点の AK YW: 2 桁日付コード </td> </tr> </tbody> </table>				変更前	変更後	製品マーキング変更	XX AYW ここでは、 XX: デバイス表記 A: カルモナ拠点の P YW: 2 桁日付コード	XX AYW ここでは、 XX: デバイス表記 A: ASEKS 拠点の AK YW: 2 桁日付コード																						
	変更前	変更後																													
製品マーキング変更	XX AYW ここでは、 XX: デバイス表記 A: カルモナ拠点の P YW: 2 桁日付コード	XX AYW ここでは、 XX: デバイス表記 A: ASEKS 拠点の AK YW: 2 桁日付コード																													



認定計画:

デバイス名: MC33274ADR2G

パッケージ: SOIC 14

RMS:

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65 °C to +150°C	500 cyc
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1@ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec	
PD	JESD22 B100,B108		
WBS	AEC-Q100-001		
WBP	Mil-Std-883 Method 2011		

デバイス名: MC33204DR2G

パッケージ: SOIC 14

RMS:

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs

デバイス名: MC33179DR2G

パッケージ: SOIC 14

RMS:

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs

デバイス名: MC33275D-3.3R2G

パッケージ: SOIC 8

RMS:

テスト	仕様	条件	間隔
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, 100 % max rated Vcc	1008 hrs
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22774XA

発行日 : 1 August 2019

デバイス名: MC33272ADR2G

パッケージ: SOIC 8

RMS :

テスト	仕様	条件	間隔
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs
TC	JESD22-A104	Ta= -65 °C to +150°C	500 cyc
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1@ 260°C	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265°C, 10 sec	
SD	JSTD002	Ta = 245°C, 10 sec	
PD	JESD22 B100,B108		
WBS	AEC-Q100-001		
WBP	Mil-Std-883 Method 2011		

認定完了予定日 : 2 December 2019

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
LM201ADR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
LM201AVDR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
LM211DR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
LM2931AD-5.0R2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
LM2931CDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
LM2931D-5.0R2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
LM301ADR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
LM311DR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC1455BDR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC1455DR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC1496BDR2G	MC33274ADR2G
MC1496DR2G	MC33274ADR2G
MC33071ADR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC33071DR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC33171DR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC33201DG	MC33204DR2G, MC33204DR2G
MC33201DR2G	MC33204DR2G, MC33204DR2G



初回製品 / プロセス変更通知

文書番号# : IPCN22774XA

発行日 : 1 August 2019

MC33201VDR2G	MC33204DR2G, MC33204DR2G
MC34071ADR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC34071DR2G	MC33204DR2G, MC33274ADR2G
MC78L05ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L05ACDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L08ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L09ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L12ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L12ACDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L15ABDG	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L15ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC78L15ACDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC79L05ABDG	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC79L05ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC79L05ACDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC79L12ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC79L12ACDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC79L15ABDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
MC79L15ACDR2G	MC33272ADR2G, MC33179DR2G
NE592D14G	MC33274ADR2G